

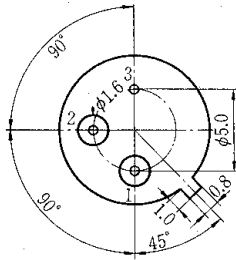
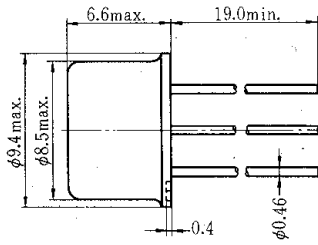
2SC2208(H)

シリコン NPN エピタキシャルLTP形

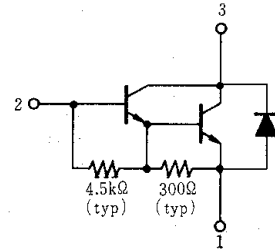
高利得増幅用
中速度電力スイッチング用

SILICON NPN EPITAXIAL LTP

HIGH GAIN AMPLIFIER
MEDIUM SPEED POWER SWITCHING



1. エミッタ: Emitter
 2. ベース: Base
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)



(JEDEC TO-39)

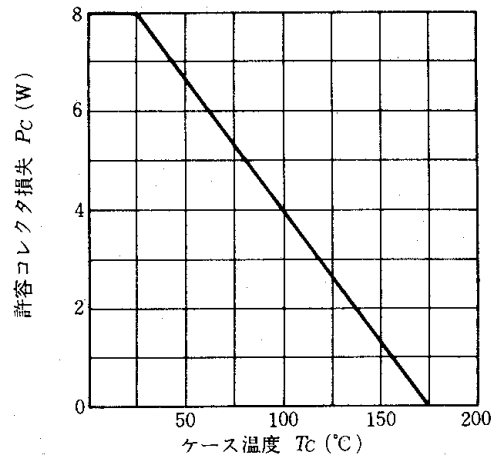
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SC2208(H)	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	120	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	120	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	I_C	5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(pusk)}$	10	A
ベース電流	I_B	1	A
許容コレクタ損失	P_C	0.8	W
	P_{C^*}	8	W
接合部温度	T_j	175	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65~+175	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

*Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	120	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=50\text{mA}, I_C=0$	7	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=120\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	mA
	I_{CEO}	$V_{CE}=100\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=5\text{mA}^*$	1000	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$		—	—	2.2	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C=5\text{A}, I_{B1}=-I_{B2}=10\text{mA}$	—	0.4	—	μs
ターンオフ時間	t_{off}		—	4.0	—	μs

*パルス測定

*Pulse Test